多相インバータとマルチコアトランスを用いた 周波数逓倍回路の出力電圧補償法

藤田 祐輔* 伊東 淳一(長岡技術科学大学)

A Compensation Method of the Output Voltage for Frequency Multiplying Circuit Constructed from a Multi-Phase Inverter and Multi-Core Transformers Yusuke Fujita^{*}, Jun-ichi Itoh, (Nagaoka University of Technology)

This paper discusses a series resonant type of a high frequency DC/AC converter. This converter consists of a multi-phase inverter and multiple numbers of core transformers. In this paper, the transformer loss is evaluated in high frequency operation. Thus, a output voltage compensation method is proposed to improve the power factor. The effectiveness of the proposed method is confirmed in experiments.

キーワード:高周波電源,中性点電位変動,マルチコアトランス,漏れインダクタンス,直列共振 (High frequency power supply, Neutral voltage fluctuation, Multiple core transformer, Leakage inductance, Series resonance)

1. はじめに

近年,自動車の燃費向上や二酸化炭素排出量の削減を目 的として,電気自動車の開発が盛んにおこなわれている⁽¹⁾。 しかしながら,現状の電気自動車のバッテリのエネルギー 密度はガソリン車と比較して小さく,充電一回当たりの走 行距離が短い。そのため,頻繁に充電する必要があるため, ガソリン車と比較した際にユーザの利便性が損なわれてお り,電気自動車普及の妨げとなっている。これらの問題を 解決する方法として,中距離大電力の比接触給電技術が近 年盛んに研究されている⁽²⁾。非接触給電技術には,法律上の 観点から ISM 帯を用いての電力伝送が必要とされるため, 13.56MHz の周波数を用いなければならない。そのため,非 接触給電には MHz 帯の出力が可能な電源装置が必要とされ ている。

従来の高周波電源装置は真空管やパワーMOSFET などの 半導体素子を用いた C 級リニアアンプ方式で構成されるこ とが多い。そのため、原理的に効率が低く、ヒートシンク やファンなどの放熱機器を負荷する必要があり、システム が大型となる。また、真空管方式では素子の寿命が短いた め信頼性に問題がある。

一方, IGBT や MOSFET などの電力変換用半導体素子は, 近年性能が向上し低損失化,大容量化が進み誘導加熱装置 用インバータなどに使われている⁽³⁾。しかし,半導体素子の スイッチング速度の制約から,高周波動作には限界がある。 特に大容量における高周波化は困難とされている。そこで, 多相インバータの中性点電位変動に注目しマルチコアトラ ンスを組み合わせた回路構成で周波数を逓倍できる方法を 利用する⁽⁴⁾⁽⁵⁾。この方式を5相インバータに適用することで, スイッチング周波数の5倍の周波数の出力を得ることが出 来る。これにより,同じ出力周波数を得るために求められ る素子のスイッチング周波数を1/5に低減することが可能 である。しかし,本方式を用いた場合,トランスを回路に 含むため,漏れインダクタンスの影響を受ける。MHz帯で の動作において,インダクタンス成分は大きな損失につな がるため,高出力を得ることは難しい。

本論文では、多相インバータとマルチコアトランスを用 いた周波数逓倍回路のトランス二次側に共振用コンデンサ を直列に挿入することで漏れインダクタンスと共振させ、 高出力化させる事を目的とする。まず始めに、トランスパ ラメータの励磁インダクタンスと漏れインダクタンスが回 路に流れる電流に及ぼす影響について明確化する。その後、 共振による出力向上について実機による動作検証を行い、 周波数逓倍回路において本手法が有効であり、出力電圧が 向上することを示す。

2. 周波数逓倍回路の動作原理

周波数逓倍回路では、電圧形インバータの負荷中性点の 電圧変動に着目している。N 相インバータを方形波駆動す ると、直流リンク電圧の中点 O を基準とする負荷中性点電 位は(1)式にて変動し、インバータのスイッチング周波数の N 倍の周波数が得られる。

 $v_{no} = \frac{1}{N} \sum v_{ko} \qquad \dots \tag{1}$

ただし、*v_{ko}*は各相の直流リンク電圧の中点**O**を基準とした出力電圧である。提案回路では、この原理を利用して昇

圧する。なお,提案法は中性点電位変動を利用するため, 相数Nは奇数でなくてはならない。

図 1(a)に提案法を 5 相電圧形インバータに適用した場合 の提案回路を示す。5 相電圧形インバータは、各相の電圧指 令をそれぞれ 72 度ずつ位相シフトさせて方形波駆動する。 図 1(b)は実機に使用したマルチコアトランスである。

図2に、提案回路の周波数増幅の原理図を示す。負荷中 性点電位は、(1)式より各相電圧の波形の総和となるため、 負荷中性点電位の波形は36度ごとにオンオフを繰り返す方 形波となり、その周波数は各相電圧の周波数の5倍となる。

負荷中性点電位の変動は、直流リンクの中性点とトラン スの中点を接続することでトランスの二次側に出力可能に なる。トランスの二次側は直列接続であるため、二次側の 電圧振幅は(1)式の5倍になる。したがって、二次側には、 振幅が各相電圧と等しく、周波数が5倍の方形波が出力さ れる。

3. マルチコアトランス

〈3・1〉マルチコアトランスの設計

実機に用いるトランスにトロイダルマルチコアトランス 方式を採用しトランスの設計を行った。トロイダルコアに は高周波に置いて低損失であるフェライトコア(TDK 製, PC40 T38×14×22)を使用した。

表 1 に回路の設計指標を示す。入力電圧 V_{in} =100V,出力 周波数 f_{out} =2.5MHz として設計を行う。マルチコアトランス では、トランス二次側を直列接続するため、トランスの段 数を n とすると(2)式の関係がある。

したがって、5 相 (n=5) で設計した場合、1 相のトラン スにおける入出力比は 1:2、動作周波数は $f_1=300$ kHz となる。 各トランス1つあたりで設計を行い、それを n 段組み合わ せ、マルチコアトランスとする。

トランス巻数の設計には(3)式を用いる。(3)式により,一 次巻数 N₁を決め,電圧比から二次巻数 N2 を決定する。

$$N_1 = \frac{V_{in}D}{\Delta B \cdot S \cdot f_1} \tag{3}$$

ただし, ΔB: 駆動磁束密度, S: トランスコアの実効断面 積, D: 1 相あたりのデューティ比である。

表1の値を用いて、一次巻数 N_1 を計算すると $N_1=5$ となる。したがって、二次巻数 N_2 は(4)式より $N_2=10$ となる。



実際にトランスを作製する際は、配線インダクタンスを 低減するために、トランスのコアは5角形に配置する。ト ランスの1次側はそれぞれのコアに集中巻し、中性点をコ ンデンサの中点に接続する。トランスの2次側はすべての コアに貫通巻することで配線長を短くすることが可能であ る。表2に実際に作成したトランスのパラメータを示す。

〈3・2〉漏れインダクタンスと励磁インダクタンスが回路に

与える影響

高周波動作を行う際,回路におけるインダクタンス成分 は大きな損失を伴う。本回路では、マルチコアトランスを 用いるため、トランスの励磁インダクタンスと漏れインダ クタンスが回路中に含まれる。



(a) Main circuit



(b) Multi-core transformer

Figure 1. Multiplying frequency circuit using five-phase inverter



Figure 2. Principle of the proposed circuit

図3に本回路のU相インバータの電圧とU相から流れる 電流を示す。理想トランスを用いると、電流は電圧の5倍 の周波数の方形波となる。これはトランスの二次側に流れ る電流が各インバータ電圧の5倍の周波数であるためであ る。つまり、コアの磁束の変化がスイッチング周波数の5 倍であるためにトランス一次側に流れる電流も 5 倍の方形 波となる。次に仮に励磁インダクタンスのみを与えた場合 は、先ほどの方形波にスイッチング周波数と同じ周波数の 三角波が重畳される。これは、励磁電流によるもので、励 磁インダクタンスの値が大きいほど三角波の振幅は小さく なる。理想トランスの状態に近づけるには励磁インダクタ ンスを大きくする必要がある。また、漏れインダクタンス のみを考慮した場合、周波数はスイッチング周波数の5倍 のままで、波形が方形波から三角波になる。漏れインダク タンスの値が大きくなるほど電流の振幅は小さくなる。つ まり,理想トランスの状態に近づけるには限りなくゼロに 近づける必要がある。実際のトランスは励磁インダクタン スと漏れインダクタンスを両方含むので、電流波形はスイ ッチング周波数と同じ周波数の三角波に,5倍の周波数の三 角波が重畳される。つまり、本回路には大きな励磁インダ クタンスを持ち、漏れが小さいトランスが必要となる。

4. 実機評価

〈4・1〉実機実験による確認

表 2 に示したトランスパラメータを用いてシミュレーションと実機実験によるトランスの評価を行った。回路パラメータは,直流入力100V一定,スイッチング周波数500kHz, デッドタイムは160nsとし,負荷には純抵抗負荷を用いる。 また,主回路の素子は,MOSFET(RENESAS製,H5N2508DL) を使用している。

図 4,5 に負荷 100Ω時のシミュレーション波形と実験結 果を示す。シミュレーション波形は実験波形と概ね一致し



Figure 3. Effect of the leakage inductance and magnetizing inductance

ており,シミュレーションモデルによる再現ができている といえる。

図 6 にシミュレーションと実機実験による負荷値変更時 の出力電力変化のグラフを示す。シミュレーション結果と

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Primary Voltage	V_{I}	50	V
Secondary Voltage	V_2	100	V
Primary Number of Turn	N_I	5	turns
Secodary Number of Turn	N_2	10	turns
Primary Frequency	f_I	500	kHz
Primary Frequency	f_2	2.5	MHz
Duty cycle	D	0.5	
Flux density	B_m	0.3	Т
Cross-sectional area	S	112×10^{6}	m ²

Table 1. Specification of transformer

Table 2. Parameters of transformer

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Primary Leakage Indactance	L_I	0.42	μH
Secondary Leakage Indactance	L_2	5.47	μH
Magnetizing Indactance	М	83.5	μH
Primary Resistance	R_I	0.25	Ω
Secondary Resistance	R_2	1	Ω



Figure 4. Simulation waveform with 100 ohm resistive load



Figure 5. Operation wavefome with 100 ohm resistive load

実機結果の傾向が一致していることを確認した。全領域に おいて実機実験がシミュレーションより低出力となるが, これは実機において発生する配線インダクタンス等の寄生 成分による損失があるためである。また,負荷値に比例し て出力電力が線形的に増加していることから,トランス二 次側の電流が一定であることがわかる。つまり実機におい て用いているトランスは電流源と見なせるほど漏れインダ クタンスが大きく,その影響が支配的である。

〈4・2〉 直列共振による出力電圧の増大

本回路の出力を向上させるためには,漏れインダクタン スを極力小さくすることが必要であるが,回路に含まれる インダクタンス成分をゼロにすることは物理的に不可能で ある。そのため,トランスの二次側に直列にコンデンサを 接続することで共振を起こしインダクタンス成分を低減す る。

実機実験においては、負荷に直列に共振用可変コンデン サ(明電舎製, SCV-151H55UW)を接続し、コンデンサの値の 変化に対する出力を検討する。RC 負荷のパラメータは RLC メータを用いて測定した。

図7は図5の測定と同様の条件において、共振用コンデンサの値を158pFに設定した際の実験結果を示す。共振用コンデンサを追加することで出力電力は2Wから6Wに向上している。実験波形は三角波から正弦波に近づいていることが確認できる。

図8に100Ω,50Ω,33Ωの各負荷時において直列共振コ ンデンサの値を変化させた際の出力電圧の変化を示す。各 負荷の値に比例して電圧値が上昇していることがわかる。 50Ωと33Ω時はほぼ同じコンデンサの値で出力電圧値が急 峻に低下している。100Ω時においても変化量はなだらかで あるが、150pF付近から出力電圧が低下している。

図 9 に直列共振コンデンサの値を変化させた際のトラン ス二次側電流の特性を示す。こちらは負荷の変化に対して 電流値にほぼ差は生じない。純抵抗負荷の測定時と同様に トランスのインダクタ成分が支配的であるために,電流源 と同様の動作をしていることがわかる。また,電流波形に おいても電圧波形と同様のコンデンサの値でそれぞれ急峻 な変化が起こっている。

図10は、図9の電流値と抵抗値から求めた出力電力の特性を示す。図6の純抵抗時のそれぞれの出力電力と比較すると、急峻な変化によって値が低下するコンデンサの値より大きなコンデンサを用いることで、出力電力の向上が確認できる。

既にピークの直後に電圧低下の結果が出ている100Ωについては異なる結果となることが予想できるが、50Ω、33Ωにおいては、波形化突然別の傾向へ切り替わっていることから、切り替わりが起こらなければ電圧電流の傾向からより高い出力が期待できる。

〈4・3〉中性点クランプの発生

図 11, 12 に図 8, 9, 10 において急激に出力値が変化す



Figure 6. Load characteristics of the output power



Figure 7. Operation wavefome with 100 ohm and 158 pF



Figure 8. Relationship between series resonance capacitor and the output voltage



Figure 9. Relationship between series resonance capacitor and the output current

る前後の条件における波形を示す。それぞれ負荷 33Ωの波 形であり,図11はC=120pF,図12はC=125pFの条件であ りCの値の差は5pFである。この際の出力の差は2.4Wであ る。図11の波形から、インバータ電圧が逆極まで電位が変 動している部分を見ると、インバータ電流がゼロになって いることがわかる。この原因となるのは中性点クランプ現 象で、インバータ電流がデッドタイム中にゼロになること でインバータ出力電圧が不定となる。この現象は共振用コ ンデンサを接続することで、トランスの漏れインダクタン スが低減され、デッドタイム中に還流が終了することで生 じる。クランプされることにより電流がひずむため、トラ ンスの出力が著しく低下する。

図 8, 9, 10 のコンデンサの容量を小さくすることで中点 クランプが発生しているという点については,共振点に近 づく事で,インダクタ成分が低減し,デッドタイム期間中 に電流の還流が終わることを示すため,デッドタイムを短 縮することによりこの条件をずらし,さらに出力を大きく することが期待できる。

図 13,14,15 に負荷に 1.6µH のインダクタを追加してコン デンサの値を振った時の出力の変化を示す。コンデンサの 変化に対して、クランプが発生する 150pF 付近までは同様 の出力変化を示す。インダクタを追加したことで還流にか かる時間が延長され、クランプが発生せずに C の値がさら に小さい領域でも出力を維持していることが確認できる。

図 16 に C=126pF の点で, 1.6 µH のインダクタを加えた際 の測定結果を示す。インダクタを追加することでクランプ 現象を抑制でき,出力電圧が増加していることが確認でき る。このことから,出力を伸ばすためにはクランプの発生 を抑制することが重要であると言える。

5. まとめ

本論文では、周波数逓倍回路の高効率化において問題と なるトランスの漏れインダクタンスを二次側でコンデンサ 共振させることで低減し、従来と比較して高出力化するこ とが出来る事を実機実験から確認した。この結果、共振を 行う前と比較して100Ω負荷において3倍の出力電力を達成 している。

今後の課題として、等価回路を用いたシミュレーション モデルを作成し、直列共振および並列共振の比較検討を行 う。実験結果とシミュレーション結果を比較検討し、提案 法の有効性を定量的に検証する、また、出力電圧をさらに 改善するため、デッドタイム時間をさらに短くしてクラン プ現象の発生を抑制する。これにより、理論上出力がピー クとなる共振点まで出力を向上できることを確認する。ま た、共振とは異なる観点から、マルチコアトランスの漏れ インダクタンスの低減を達成する巻線構造の見直しについ ても検討する。



Figure 10. Relationship between series resonance capacitor and the



Figure 11. Operation waveform with 33 ohm and 120 pF







Figure 13. Relationship between series resonance capacitor and the output voltage

献

文

- (1) T. Teratani, S. Okuma: "Automotive Technology Evolved by Electrical and Electronics Systems", T.IEEJapan, Vol. 125-D, No. 10, pp.887-894(2005)
 寺谷・大熊:「電気が進化させる自動車技術」,電学論 D, Vol.125, No. 10, pp.887-894(2005)
- (2) Y. Hori, "Future Vehicle Society based on Electric Motor, Capacitor and Wireless Power Supply," Power Electronics Conference (IPEC), pp. 2930-2934 (2010)
- (3) D. Goodman, A. Bortkiewicz, G. Alley, and W. Holber, "RF Power Supply With Integrated Matching Network," U.S. Patent 6 887 339, Sep. 20 (2001)
- (4) H. Nishiyama, K. Orikawa, S, Miyawaki, J. Itoh: "Consideration of a Frequency Amplify Power Converter Using a Neutral Voltage Fluctuation of a Square-wave Inverter and a Multiple Core Transformer", SPC-11-036 (2010)
 西山, 折川, 宮脇, 伊東: 「方形波駆動時のインバータ中性点電位変

国山, 切川, 呂陽, F来. 「カル液源動時のインパークービニ電位変動とマルチコアトランスを用いた周波数増幅電力変換器の一考察」, SPC 兵庫, SPC-11-036 (2010)

(5) J. Itoh, Y. Fujita, H. Nishiyama: "Frequency Multiplying Circuit Constructed from a Multi-phase Inverter and Multi-core Transformers", ECCE Asia, pp. 807-813 (2012)



Figure 14. Characteristics of output current with 1.6µH inductor



Figure 15. Characteristics of output power with 1.6µH inductor



Figure 16. Comparison between the waveform with 1.6µH inductor and without inductor

(C=126pF)